

Столкновительные времена жизни элементарных возбуждений в двумерных системах в поле сильной электромагнитной волны

В. М. Ковалев¹⁾

Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, 630090 Новосибирск, Россия

Новосибирский государственный технический университет, 630073 Новосибирск, Россия

Поступила в редакцию 30 ноября 2017 г.

Рассматривается двумерная система с двумя неэквивалентными долинами в поле сильной циркулярно-поляризованной электромагнитной волны. Предполагается, что оптические правила отбора для заданной поляризации света разрешают межзонные переходы лишь в одном – оптически активном – типе долин (двумерный слой на основе дихалькогенидов переходных металлов, щелевого графена и других), приводя к формированию фотонно-связанных электрон-дырочных пар – состояние “оптического изолятора”. Предполагается, что во втором – оптически неактивном – типе долин имеется равновесный электронный газ. Изучается затухание элементарных возбуждений гибридной системы электронный газ – газ электрон-дырочных пар, обусловленное кулоновским взаимодействием частиц.

DOI: 10.7868/S0370274X18030086

Введение. Физические свойства двумерных систем на основе дихалькогенидов переходных металлов (ДПМ) в настоящее время представляют значительный интерес [1], что стимулировало интенсивный поток публикаций как по оптическим, так и по транспортным свойствам этих материалов. В области оптики ДПМ-материалов особое внимание уделяется свойствам экситонных возбуждений [2, 3], поскольку последние возможно наблюдать вплоть до комнатных температур. Кроме оптических свойств одиночных экситонов [4] интенсивно изучаются также и коллективные свойства экситонных газов, в том числе возможность формирования фазы бозе-эйнштейновского конденсата [5] с высокой температурой фазового перехода [6, 7].

В настоящем сообщении мы хотим обратить внимание на возможность формирования гибридной бозон-фермионной системы в слое ДПМ в поле сильной электромагнитной волны. Оптические правила отбора в слое ДПМ разрешают переходы лишь в одном типе долин при заданной циркулярной поляризации электромагнитного поля [8]. В сильном резонансном поле в оптически активном типе долин возможно формирование состояния типа оптического изолятора [9, 10], элементарными возбуждениями которого являются квазичастицы, представляющие собой фотонно-связанные электрон-дырочные пары. Напротив, в оставшемся типе долин, согласно правилам отбора, оптические переходы запрещены и со-

стояние носителей заряда остается равновесным. В зависимости от начального положения уровня Ферми, в оптически неактивном типе долин имеется либо диэлектрическое состояние системы, когда уровень Ферми лежит внутри запрещенной зоны материала, либо имеется электронный (дырочный) газ, когда уровень Ферми находится в зоне проводимости (валентной). Здесь и далее будет рассматриваться случай нулевой температуры. Таким образом, в стационарном состоянии в поле сильной электромагнитной волны можно ожидать формирования гибридной бозон-фермионной системы.

Изучение гибридных систем на основе пространственно-разделенных электронного и экситонного газов активно проводилось в ряде работ. Было показано, что такая система может обладать рядом интересных физических свойств, что обусловлено электрон-экситонным взаимодействием [11–18].

В настоящем письме мы анализируем свойства элементарных возбуждений гибридной системы в слое ДПМ в присутствии сильной электромагнитной волны. Рассматриваются дисперсия и собственное затухание коллективных мод (колебания плотности) газа электрон-дырочных пар в оптически активном типе долин, изучаются дисперсия и затухание гибридных коллективных мод, представляющих собой взаимодействие колебаний плотности электронов (плазмонов) в оптически-неактивном типе долин и коллективных мод газа электрон-дырочных пар. Рассмотрено также время жизни одиночного элек-

¹⁾e-mail: vadimkovalev@isp.nsc.ru

трона неактивной долины, обусловленное столкновением электрона с электрон-дырочными парами оптически активной долины вблизи порога диссоциации электрон-дырочных пар.

Гамильтониан. Гамильтониан слоя ДПМ в поле внешней электромагнитной волны, описываемой векторным потенциалом $\mathbf{A}(t) = \mathbf{A}e^{-i\Omega t} + \mathbf{A}^*e^{i\Omega t}$ с амплитудой $\mathbf{A} = A_0(1, i\sigma)$ (σ – степень поляризации), имеет следующий вид

$$H = \frac{\Delta}{2}\sigma_z + \mathbf{v}\mathbf{p} + \frac{e}{c}\mathbf{v}\mathbf{A}(t), \quad (1)$$

где оператор скорости $\mathbf{v} = v_0(\eta\sigma_x, \sigma_y)$, v_0 – зонный параметр, Δ – ширина запрещенной зоны материала и $\eta = \pm 1$ – индекс долины. Первые два слагаемых в (1) могут быть диагонализированы. В представлении валентная зона – зона проводимости, гамильтониан (1) запишется как (в электронном представлении)

$$H = \begin{pmatrix} \Omega_p & 0 \\ 0 & -\Omega_p \end{pmatrix} + \frac{e}{c} \begin{pmatrix} \mathbf{v}_{cc} & \mathbf{v}_{cv} \\ \mathbf{v}_{vc} & \mathbf{v}_{vv} \end{pmatrix} \mathbf{A}(t), \quad (2)$$

где $\Omega_p = \sqrt{(v_0p)^2 + \Delta^2/4}$, а \mathbf{v}_{ij} – матричные элементы оператора скорости. В дальнейших вычислениях используем квадратичное приближение для спектра, а именно, при $v_0p \ll \Delta/2$ имеем $\Omega_p = \Delta/2 + p^2/2m$, где эффективная масса $m = \Delta/2v_0^2$.

В резонансном приближении (приближение вращающейся волны), когда частота света близка к ширине запрещенной зоны материала, $|\Omega - \Delta| \ll \Delta$, второе слагаемое в (2) можно представить следующим образом [19]:

$$\begin{pmatrix} 0 & \lambda e^{-i\Omega t} \\ \lambda e^{i\Omega t} & 0 \end{pmatrix}, \quad (3)$$

где $\lambda = \lambda_0(1 + \eta\sigma\Delta/2\Omega_p)$ – межзонный матричный элемент, $\lambda_0 = eA_0/c$ и σ – степень циркулярной поляризации света. В приближении эффективной массы $\lambda \approx \lambda_0(1 + \eta\sigma)$. Выражение (3) определяет селективные по долинам оптические правила отбора: межзонный переход разрешен при условии $\eta\sigma = 1$. С учетом внутримолекулярных оптических правил отбора получаем

$$\mathcal{H} = \int d\mathbf{r}\Psi^\dagger(\mathbf{r}, t)H_L\Psi(\mathbf{r}, t) + \int d\mathbf{r}\Phi^\dagger(\mathbf{r}, t)H_R\Phi(\mathbf{r}, t) + \int d\mathbf{r}d\mathbf{r}'\Psi^\dagger(\mathbf{r}, t)\Psi(\mathbf{r}, t)V(\mathbf{r} - \mathbf{r}')\Phi^\dagger(\mathbf{r}', t)\Phi(\mathbf{r}', t), \quad (4)$$

где

$$H_L = \begin{pmatrix} \Omega_p & \lambda e^{-i\Omega t} \\ \lambda e^{i\Omega t} & -\Omega_p \end{pmatrix}, \quad H_R = \begin{pmatrix} \Omega_p & 0 \\ 0 & -\Omega_p \end{pmatrix}.$$

Будем полагать, что оптические переходы разрешены в долине, которую, для определенности, назовем “левой” (H_L) и запрещены в “правой” (H_R).

В гамильтониане \mathcal{H} оператор $V(\mathbf{r}) = e^2/r$ – кулоновское взаимодействие частиц. Подчеркнем, что мы пишем оператор взаимодействия частиц в диагональном представлении по зонам. В принципе, оператор $V(\mathbf{r})$ имеет также и межзонные матричные элементы, описывающие процессы рассеяния с большой передачей энергии порядка ширины запрещенной зоны Δ , которыми будем пренебрегать. Мы также пренебрежем процессами рассеяния с большой передачей импульса – междолинным рассеянием.

Гамильтониан H_L может быть диагонализирован во вращающейся системе координат, переход в которую осуществляется унитарным преобразованием $S_t = \exp(-i\sigma_z\Omega t/2)$ [19].

Статическое экранирование и коллективные моды. Суммирование петлевых диаграмм дает

$$V_{k\omega} = \frac{V_k^0}{\varepsilon_{k\omega}}, \quad \varepsilon_{k\omega} = 1 - V_k^0(P_{k\omega}^R + \Pi_{k\omega}^R), \quad (5)$$

где $V_k^0 = 2\pi e^2/k$ – затравочное кулоновское взаимодействие частиц, и $P_{k\omega}^R, \Pi_{k\omega}^R$ – поляризационные операторы газа электрон-дырочных пар (левая долина), и электронного газа (правая долина), соответственно.

Следуя стандартной процедуре расчета [20], в режиме насыщения получаем поляризационный оператор электрон-дырочных пар оптически активной долины

$$P_{k\omega}^R = \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{p}} \frac{\varepsilon_{\mathbf{p}}\varepsilon_{\mathbf{p}'} - \xi_{\mathbf{p}}\xi_{\mathbf{p}'} - \lambda^2}{\varepsilon_{\mathbf{p}}\varepsilon_{\mathbf{p}'}} \times \left(\frac{1}{\omega + i\delta - \varepsilon_{\mathbf{p}} - \varepsilon_{\mathbf{p}'}} - \frac{1}{\omega + i\delta + \varepsilon_{\mathbf{p}} + \varepsilon_{\mathbf{p}'}} \right), \quad (6)$$

где $\varepsilon_{\mathbf{p}} = \sqrt{\xi_{\mathbf{p}}^2 + \lambda^2}$, $\xi_{\mathbf{p}} = (p^2 - p_c^2)/2m$, $p_c^2/2m = (\Omega - \Delta)/2 > 0$ и $\mathbf{p}' = \mathbf{p} + \mathbf{k}$. Поляризационный оператор электронов при $k \ll p_F$, $\omega \ll \epsilon_F$ имеет вид

$$\Pi_{k\omega}^R = -\frac{m}{\pi} \left[1 - \frac{|\omega|}{\sqrt{\omega^2 - k^2v_F^2}} + i \frac{\omega}{\sqrt{k^2v_F^2 - \omega^2}} \right]. \quad (7)$$

Начнем наше рассмотрение с ситуации отсутствия электронов в правой долине, т.е. при $\Pi_{k\omega}^R = 0$. В статическом пределе из (6) получаем $\varepsilon_{k,0} = 1 + k\beta$, где $\beta = \frac{a_B}{3} \left(\frac{\xi_0}{a_B} \right)^2$ и $\xi_0 = p_c/m\lambda$ – длина когерентно-

сти. В результате для экранированного кулоновского потенциала имеем

$$V(\mathbf{r}) = \int_0^\infty dk \frac{V_k^0}{\varepsilon_{k,0}} J_0(kr) = \quad (8)$$

$$= \frac{\pi e^2}{2\beta} \left[H_0\left(\frac{r}{\beta}\right) - N_0\left(\frac{r}{\beta}\right) \right] \approx \frac{e^2}{r}.$$

Здесь последнее равенство написано для предельного случая $r \gg \beta$. Таким образом, на больших расстояниях поведение кулоновского потенциала не изменяется.

Перейдем теперь к рассмотрению коллективных мод, дисперсия которых определяется уравнением $\varepsilon_{k\omega} = 1 - V_k^0 P_{k\omega}^R = 0$. Анализ показывает, что в области $\omega < 2\lambda$ коллективные моды отсутствуют. В области $\omega > 2\lambda$ уравнение $1 - V_k^0 P_{k\omega}^R = 0$ принимает вид

$$1 - \frac{2}{ka_B} \left[\frac{(v_c k)^2}{\omega^2 - 4\lambda^2} - i \frac{2\pi(\lambda v_c k)^2}{\omega^3 \sqrt{\omega^2 - 4\lambda^2}} \right] = 0, \quad (9)$$

где параметр v_c определяется соотношением $mv_c^2 = \Omega - \Delta > 0$ и $a_B = 1/(me^2)$. Выражение (9) получено при условии $k\xi_0 \ll 1$. Решая (9) итерациями, находим закон дисперсии и затухание коллективных мод

$$\omega^2 = 4\lambda^2 + \frac{2v_c^2 k}{a_B} - i \frac{4\pi v_c (v_c \lambda)^2 \sqrt{2a_B}}{(4\lambda^2 + 2v_c^2 k/a_B)^{3/2}} k^{3/2}. \quad (10)$$

При наличии электронов во второй долине удобно рассмотреть несколько случаев. Очевидно, что при $2\lambda, v_F k > \omega$ коллективные моды отсутствуют. В области $2\lambda, v_F k < \omega$ имеем

$$1 - \left[\frac{\omega_k^2}{\omega^2 - 4\lambda^2} + \frac{\omega_p^2}{\omega^2} - i \frac{2\pi\lambda^2 \omega_k^2}{\omega^3 \sqrt{\omega^2 - 4\lambda^2}} \right] = 0, \quad (11)$$

где введены краткие обозначения $\omega_k^2 = 2v_c^2 k/a_B$, $\omega_p^2 = v_F^2 k/a_B$. Это уравнение удобно представить в виде

$$(\omega^2 - \omega_1^2)(\omega^2 - \omega_2^2) - 2\pi i (\lambda \omega_k)^2 \frac{\sqrt{\omega^2 - 4\lambda^2}}{\omega} = 0, \quad (12)$$

$$\omega_{1,2}^2 = 2\lambda^2 + \frac{\omega_k^2 + \omega_p^2}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{[(2\lambda - \omega_p)^2 + \omega_k^2][(2\lambda + \omega_p)^2 + \omega_k^2]},$$

где при малых k частота ω_1 имеет щель 2λ , а ω_2 является бесщелевой. Затухание этих мод находится подстановкой $\omega = \omega_{1,2}$ в мнимую часть выражения (12).

В области $2\lambda > \omega > kv_F$ имеется чистая незатухающая плазменная мода. В области $kv_F > \omega > 2\lambda$ (что возможно лишь при $k > k_0 = 2\lambda/v_F$) имеем

$$1 - \frac{\omega_k^2}{\omega^2 - 4\lambda^2} - \frac{2}{ka_B} + \quad (13)$$

$$+ i \left[\frac{2\pi(\lambda \omega_k)^2}{\omega^3 \sqrt{\omega^2 - 4\lambda^2}} + \frac{2\omega}{ka_B \sqrt{k^2 v_F^2 - \omega^2}} \right] = 0.$$

Из выражения (13) следует, что взаимодействие с электронным газом перенормирует закон дисперсии при $k > k_0$:

$$\omega^2 = 4\lambda^2 + \omega_k^2 \frac{ka_B}{2 + ka_B} \quad (14)$$

и дает дополнительное затухание

$$\text{Im} \omega^2 = - \frac{4\lambda ka_B \omega_k^2 \theta[k^2 - k_0^2]}{(2 + ka_B)^2 v_F \sqrt{k^2 - k_0^2}}, \quad (15)$$

которое, впрочем, носит пороговый характер.

Отметим, что дисперсионные выражения (10)–(14) получены при условии $\omega\tau \gg 1$, где τ – время внутризонной релаксации. Кроме этого, должно также выполняться неравенство $\lambda\tau \gg 1$, которое описывает условие формирования когерентной суперпозиции состояний электрона в зоне проводимости и валентной зоне. На электрон-дырочном языке это неравенство означает, что энергия связи электрона и дырки должна быть больше их обратного времени релаксации.

Столкновительное время жизни электронов. Мнимая часть массового оператора электрона может быть представлена в виде

$$\text{Im} \Sigma(\xi) = - \frac{\text{sign}[\xi]}{2\pi^2} \int_0^{|\xi|} d\omega \int_{\omega/v_F}^\infty \left| \frac{V_k^0}{\varepsilon_{k\omega}} \right|^2 \times$$

$$\times \frac{kdk \text{Im} (P_{k\omega}^R + \Pi_{k\omega}^R)}{\sqrt{k^2 v_F^2 - \omega^2}}, \quad (16)$$

$$|\varepsilon_{k\omega}|^2 = [1 - V_k^0 \text{Re}(P_{k\omega}^R + \Pi_{k\omega}^R)]^2 +$$

$$+ (V_k^0)^2 [\text{Im}(P_{k\omega}^R + \Pi_{k\omega}^R)]^2.$$

Наиболее интересной является область $2v_F/a_B \gg |\xi|$. При этом возможны две ситуации, а именно $\min[2v_F/a_B; 2\lambda] \gg |\xi|$ и $2v_F/a_B \gg |\xi| > 2\lambda$. В области выполнения первого неравенства, $P_{k\omega}^R \approx 0$ и, фактически, время жизни определяется лишь электрон-электронными столкновениями. Более интересна ситуация во втором случае. Рассмотрим ее подробнее. Поскольку $2v_F/a_B \gg |\xi|$, то можно положить

$$\Pi_{k\omega}^R = - \frac{m}{\pi} \left[1 + i \frac{\omega}{\sqrt{k^2 v_F^2 - \omega^2}} \right], \quad (17)$$

и кроме того, в области $|\xi| > 2\lambda$ можно принять

$$P_{k\omega}^R = \frac{m}{\pi} \left[\frac{(v_c k)^2}{\omega^2 - 4\lambda^2} - i \frac{2\pi(\lambda v_c k)^2}{\omega^3 \sqrt{\omega^2 - 4\lambda^2}} \right] \theta[\omega^2 - 4\lambda^2]. \quad (18)$$

Общий анализ (16) с учетом (17) и (18) представляет собой сложную задачу. Мы рассмотрим лишь время жизни электронов, обусловленное диссоциацией фотонно-связанной электрон-дырочной пары вследствие столкновения с электроном, которое определяется множителем $\text{Im } P_{k\omega}^R$ в числителе выражения (16)

$$\text{Im } \Sigma(\xi) = -\frac{\text{sign}[\xi]}{2\pi^2} \int_{2\lambda}^{|\xi|} d\omega \int_{\omega/v_F}^{\infty} \left| \frac{V_k^0}{\varepsilon_{k\omega}} \right|^2 \frac{k dk \text{Im } P_{k\omega}^R}{\sqrt{k^2 v_F^2 - \omega^2}}. \quad (19)$$

Как следует из (18) $\text{Im } P_{k\omega}^R$ имеет пороговое поведение и отлична от нуля лишь при $\omega > 2\lambda$. Рассмотрим поведение (19) вблизи порога, т.е. когда $0 < \eta \ll 2\lambda$, где $\eta = |\xi| - 2\lambda$. Вблизи порога главный вклад дается первым слагаемым в (18), при этом

$$|\varepsilon_{k\omega}|^2 \approx \left[\frac{\omega_k^2}{4\lambda(\omega - 2\lambda)} \right]^2, \quad (20)$$

что после интегрирования дает

$$\text{Im } \Sigma(\xi) = \frac{\pi}{10} \text{sign}(\xi) \frac{\eta^{5/2}}{m v_c^2 \sqrt{\lambda}}. \quad (21)$$

Заключение. Таким образом, в работе показано, что многодолинность и специфические правила отбора для оптических переходов позволяют сформировать в двумерных материалах на основе дихалькогенидов переходных металлов или щелевого графена новый тип гибридной бозон-фермионной системы. Рассчитанные времена жизни показывают, что появляющиеся в такой системе элементарные возбуждения являются хорошими квазичастицами в смысле малости их времен затухания по сравнению с их дисперсией. Появление новых видов элементарных возбуждений как, например, коллективных мод газа электрон-дырочных пар (10) и гибридных мод (12) должно проявляться в циклотронном резонансе. В настоящем сообщении для простоты рассмотрения не были учтены спиновые степени свободы носителей заряда. Известно, что последние играют немаловажную роль в транспортных явлениях в ДПМ [1] и представляет также интерес рассмотрение коллективных спиновых возбуждений в ДПМ в поле

сильной электромагнитной волны. Построение теории циклотронного и спинового резонанса в монослое ДПМ, в которых должны проявляться указанные типы коллективных возбуждений, будет являться предметом дальнейших исследований.

Я благодарю А.В. Чаплика за обсуждение работы, которая выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект РНФ-17-12-01039).

1. A. V. Kolobov and J. Tominaga, *Two-Dimensional Transition-Metal Dichalcogenides*, Springer Series in Material Science (2016), v. 239.
2. M. M. Glazov, E. L. Ivchenko, G. Wang, T. Amand, X. Marie, B. Urbaszek, and B. L. Liu, *Phys. Stat. Sol. (b)* **252**, 2349 (2015).
3. G. Wang, A. Chernikov, M. M. Glazov, T. F. Heinz, X. Marie, T. Amand, and B. Urbaszek, arXiv:1707.05863.
4. A. Chernikov, T. C. Berkelbach, H. M. Hill, A. Rigosi, Y. Li, O. B. Aslan, D. R. Reichman, M. S. Hybertsen, and T. F. Heinz, *Phys. Rev. Lett.* **113**, 076802 (2014).
5. O. L. Berman and R. Ya. Kezerashvili, *Phys. Rev. B* **96**, 094502 (2017).
6. M. M. Fogler, L. V. Butov, and K. S. Novoselov, *Nature Commun.* **5**, 4555 (2014).
7. O. L. Berman and R. Ya. Kezerashvili, *Phys. Rev. B* **93**, 245410 (2016).
8. D. Xiao, G.-B. Liu, W. Feng, X. Xu, and W. Yao, *Phys. Rev. Lett.* **108**, 196802 (2012).
9. V. F. Elesin, *ЖЭТФ* **32**, 328 (1971).
10. В. М. Галицкий, В. Ф. Елесин, *Резонансное взаимодействие электромагнитных полей с полупроводниками*, Энергоатомиздат, М. (1986).
11. O. Cotlet, S. Zeytinoglu, M. Sigrist, E. Demler, and A. Imamoglu, *Phys. Rev. B* **93**, 054510 (2016).
12. F. P. Laussy, A. V. Kavokin, and I. A. Shelykh, *Phys. Rev. Lett.* **104**, 106402 (2010).
13. I. A. Shelykh, T. Taylor, and A. V. Kavokin, *Phys. Rev. Lett.* **105**, 140402 (2010).
14. M. Matuszewski, T. Taylor, and A. V. Kavokin, *Phys. Rev. Lett.* **108**, 060401 (2012).
15. M. V. Boev, V. M. Kovalev, and I. G. Savenko, *Phys. Rev. B* **94**, 241408 (2016).
16. В. М. Ковалев, А. В. Чаплик, *Письма в ЖЭТФ* **94**, 601 (2011).
17. В. М. Ковалев, А. В. Чаплик, *Письма в ЖЭТФ* **98**, 371 (2013).
18. А. В. Каламейцев, А. В. Чаплик, *Письма в ЖЭТФ* **106**, 502 (2017).
19. В. М. Ковалев, В.-К. Тсе, М. В. Энтин, *Письма в ЖЭТФ* **106**, 549 (2017).
20. А. С. Александров, В. Ф. Елесин, *ЖЭТФ* **72**, 1970 (1977).